

9. Risby T.H., Yerger A.L. // J. Phys. Chem. -1976. -**80**. -P. 2839—2845.
10. Miketova P., Abbas-Hawks C., Voorhees K.J., Hadfield T. // J. Anal. Appl. Pyrol. -2003. -**67**. -P. 109—122.
11. Bergna H.E., Roberts W.O. Colloidal silica: fundamentals and applications. New-York: CRC Press, 2006.
12. Nicholl S.I., Talley J.W. // Chemosphere. -2006. -**63**. -P. 132—141.
13. Kulyk T.V., Lipkovska N.A., Barvinchenko V.N. et al. // J. Coll. Interf. Sci. -2009. -**339**. -P. 60—68.
14. Земляков А.Е., Цикалова В.Н., Цикалов В.В. и др. // Биоорган. химия. -2006. -**32**, № 4. -С. 424—431.
15. Земляков А.Е., Цикалова В.Н., Цикалов В.В. и др. // Там же. -2005. -**31**, № 6. -С. 637—634.
16. Кулик Т.В., Паланция Б.Б., Азизова Л.Р., Тарнавский С.С. // Масс-спектрометрия. -2008. -№ 5(2). -С. 125—132.

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Київ
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського,
Сімферополь

Надійшла 24.01.2010

УДК 536.631+652:651.281

Н.П. Горбачук

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИЛИЦИДОВ Ln_5Si_3 ЦЕРИЕВОЙ ПОДГРУППЫ

На основе экспериментально определенных температурных зависимостей энталпий соединений Ln_5Si_3 ($\text{Ln} = \text{La}, \text{Pr}, \text{Gd}$) проведен расчет температурных зависимостей теплоемкости и энталпий плавления для других силицидов цериевой подгруппы.

ВВЕДЕНИЕ. Силициды редкоземельных металлов (РЗМ), благодаря своим свойствам, могут быть использованы как зеркальные покрытия для работы в агрессивных средах и при повышенных температурах, как холловские датчики, резистивные материалы в элементах микроэлектроники, выпрямляющие и омические контакты, инфракрасные детекторы, рабочие тела в экологически чистых холодильных устройствах, работающих вблизи комнатных температур и т.д. [1, 2]. Сведения о свойствах вещества, в том числе и термодинамических, являющихся фундаментальными свойствами, отражающими природу химической связи, совместно с данными о фазовых равновесиях позволяют не только проводить оценки высокотемпературных реакций с участием этих веществ на основе расчета результирующего влияния изменения изобарно-изотермического потенциала, но и прогнозировать фазовые диаграммы и термодинамические свойства экспериментально неисследованных систем и соединений.

В настоящей работе нами на основе полученных ранее экспериментальных данных по термодинамическим свойствам некоторых силицидов РЗМ цериевой подгруппы проведен расчет темпе-

ратурных зависимостей теплоемкости, а также энталпии и энтропии плавления экспериментально неисследованных силицидов состава Ln_5Si_3 ($\text{Ln} = \text{Nd}, \text{Pm}, \text{Sm}$).

Силициды Ln_5Si_3 цериевой подгруппы — одни из наиболее тугоплавких инконгруэнтно плавящихся соединений в соответствующих бинарных системах $\text{Ln}-\text{Si}$. Они кристаллизуются в гексагональной кристаллической решетке типа Cr_5B_3 [3]. При температурах выше 298.15 К все они парамагнитны и характеризуются подобием изменения физико-химических свойств [1, 3, 4].

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА. Энталпии трех силицидов La_5Si_3 , Pr_5Si_3 и Gd_5Si_3 измерены нами впервые методом смешения в интервале температур от комнатной до плавления и жидкой фазы [5 — 7]. Экспериментальные значения энталпий соответствующие твердофазному состоянию вещества аппроксимировались уравнением Майера-Келли:

$$H^0(T) - H^0(298.15 \text{ K}) = AT^2 + BT + CT^{-1} + D, \quad (1)$$

а выше температур плавления — линейной зависимостью:

$$H^0(T) - H^0(298.15 \text{ K}) = aT + b. \quad (2)$$

© Н.П. Горбачук , 2011

Для согласования низко- и высокотемпературных значений теплоемкости коэффициенты уравнения (1) определялись методом наименьших квадратов с учетом двух дополнительных условий [8]: $H^o(T) - H^o(298.15 \text{ К}) = 0$ при $T=298.15 \text{ К}$ и значение $C_p^o(298.15 \text{ К})$, полученного из низкотемпературных измерений теплоемкости и равного ($\text{Дж}\cdot\text{моль}^{-1}\cdot\text{К}^{-1}$) [9]: 207.00 (La_5Si_3), 216.70 (Pr_5Si_3), 211.85 (Gd_5Si_3). Температурные зависимости теплоемкости силицидов La_5Si_3 , Pr_5Si_3 , Gd_5Si_3 получены путем дифференцирования соответствующих уравнений Майера–Келли (1) и имеют вид:

$$C_p(T) = 2AT + B - CT^2. \quad (3)$$

Коэффициенты уравнений (1)–(3) приведены в табл. 1.

Таблица 1

Коэффициенты температурных зависимостей энталпий ($\text{Дж}\cdot\text{моль}^{-1}$) и теплоемкостей ($\text{Дж}\cdot\text{моль}^{-1}\cdot\text{К}^{-1}$) силицидов лантана, празеодима и гадолиния

Силицид	$A \cdot 10^3$	B	C	$-D$	a	$-b$
La_5Si_3	5.995	205.94	223488	62683	296.07	88273
Pr_5Si_3	18.898	213.63	728873	67819	358.13	106776
Gd_5Si_3	11.821	209.98	460627	65202	378.25	112774

РАСЧЕТ ТЕПЛОЕМКОСТЕЙ, ЭНТАЛЬПИЙ ПЛАВЛЕНИЯ СИЛИЦИДОВ. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. Теплоемкость исследованных силицидов монотонно растет вплоть до температур плавления, поэтому она может быть представлена суммой основных вкладов:

$$C_p(T) = C_{\text{ph}} + C_a + C_e + C_{f,m}, \quad (4)$$

где C_{ph} — фононная в гармоническом приближении; C_a — ангармоническая; C_e — электронная; $C_{f,m}$ — составляющая по Шоттки.

Для силицидов La_5Si_3 и Gd_5Si_3 вклад в теплоемкость по Шоттки отсутствует и их изобарная теплоемкость определяется первыми тремя членами уравнения (4). Для других силицидов характерно наличие составляющей теплоемкости по Шоттки, обусловленной термическим возбуждением $4f$ -электронов металла на более высокие энергетические уровни, возникающие в результате расщепления атомных термов спин-орбитальным взаимодействием, приводящим к появлению мультиплетной структуры этих термов [10]. В действите-

льности реальная энергетическая схема ионов РЗМ усложняется тем, что каждый мультиплетный уровень претерпевает расщепление на группу близлежащих состояний под действием электрического поля кристалла (эффект Штарка). Характер и величина расщепления зависит от природы уровня и симметрии кристаллического поля, в котором находится ион РЗМ. Штарковское расщепление уровня значительно меньше мультиплетного в связи со слабым возмущающим действием электрического поля кристалла на глубоко лежащую $4f$ -оболочку. Поэтому смещение “центра тяжести” мультиплетного уровня данного иона РЗМ при переходе от одного кристалла к другому незначительно (100 см^{-1}). Таким образом, мультиплетная структура термов трехвалентных ионов РЗМ слабо зависит от той кристаллической основы, в которой они находятся, и в расчетах может приниматься такой же, как для свободных ионов при отсутствии результатов экспериментальных исследований оптических свойств конкретных веществ.

Температурные зависимости мультиплетной компоненты $C_{f,m}$ для трехвалентных ионов РЗМ рассчитаны в работе [11]. При понижении температуры, когда переходы между мультиплетными уровнями не реализуются, штарковская структура основного состояния приводит к появлению дополнительного вклада $C_{f,\text{ш}}$ обусловленного переходами между ее компонентами. Для ионов La^{3+} , Gd^{3+} этот вклад отсутствует, поскольку у этих ионов основное состояние — синглет и не расщепляется электрическим полем кристалла. Проведенные в [11] оценки показывают, что вклад в теплоемкость, связанный с эффектом Штарка ($C_{f,\text{ш}}$), достигает максимальных значений в области температур 0–300 К и становится исчезающе мал при температурах 1000 К и выше. Другая же часть компоненты, связанная с переходами на более высокие мультиплетные уровни ($C_{f,m}$), является преобладающей в области средних и высоких температур.

Таким образом, с учетом подобия изменения физико-химических характеристик [1–4, 12], определяющих первые три вклада в уравнении (4), изобарная теплоемкость других изоструктурных силицидов цериевой подгруппы в области средних и высоких температур может быть рассчитана как сумма регулярной части и соответствующего вклада по Шоттки ($C_{f,m}$), обусловленного мультиплетной структурой термов трехвалентных ионов РЗМ. Для расчета теплоемкости экспериментально неисследованных силицидов взято уравнение:

$$C_p(T) = C_p(\text{La}_5\text{Si}_3) \cdot \frac{7-n}{7} + \\ + C_p(\text{Gd}_5\text{Si}_3) \cdot \frac{n}{7} + C_{f,M}, \quad (5)$$

где $C_p(\text{La}_5\text{Si}_3)$, $C_p(\text{Gd}_5\text{Si}_3)$ — соответственно теплоемкости силицидов лантана и гадолиния; $n=0-7$ — порядковый номер РЗМ от La до Gd; $C_{f,M}$ — мультиплетная компонента теплоемкости по Шоттки.

Величины теплоемкости силицидов лантана и гадолиния находились по уравнению (3), а величины $C_{f,M}$ для силицидов Pr_5Si_3 , Nd_5Si_3 , Pm_5Si_3 и Sm_5Si_3 взяты из работы [11].

Рассчитанные по (5) и найденные на основе экспериментальных данных по энталпии по уравнению (3) значения теплоемкости Pr_5Si_3 приведены в табл. 2, из которой видно, что рассчитанные величины теплоемкости несколько ниже эксперимен-

Таблица 2

Экспериментальные и рассчитанные значения теплоемкости ($\text{Дж}\cdot\text{моль}^{-1}\cdot\text{К}^{-1}$) Pr_5Si_3

$T, \text{К}$	Расчет по уравнениям		$\delta, \%$
	(5)	(3)	
300	208.6	216.9	-3.8
400	212.7	224.2	-5.1
500	217.5	229.6	-5.2
600	223.3	234.3	-4.7
700	229.5	238.6	-3.8
800	235.7	242.7	-2.9
900	241.7	246.8	-2.0
1000	247.4	250.7	-1.3
1100	252.7	254.6	-0.7
1200	257.6	258.5	-0.4
1300	262.0	262.3	-0.1
1400	265.9	266.2	-0.1
1500	269.4	270.0	-0.2

тальных. При этом в интервале температур 298.15—1500 К разница уменьшается от 5.2 до 0.2 %. Эта разница может быть объяснена неучетом в расчетах компоненты составляющей по Шоттки, обусловленной эффектом Штарка, которая имеет максимум при низких температурах и стремится к нулю при температурах выше 1000 К [11]. Оценка этой компоненты, проведенная нами, как разность экспериментальных величин теплоемкости Pr_5Si_3 [13] и суммы взятых в пропорциональном соотноше-

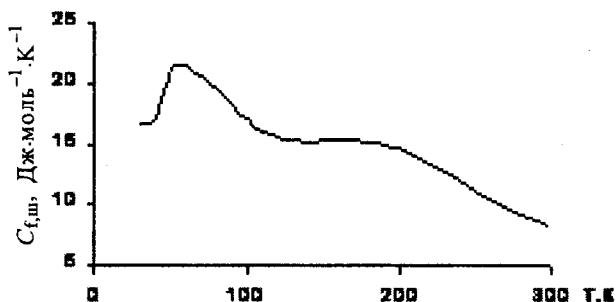


Рис. 1. Вклад в теплоемкость по Шоттки Pr_5Si_3 при низких температурах.

нии теплоемкостей La_5Si_3 [14] и Gd_5Si_3 [15] показывает (рис. 1), что ее максимум находится при 50—60 К, а при 298.15 К величина $C_{f,\text{ш}}$ составляет 8.31 $\text{Дж}\cdot\text{моль}^{-1}\cdot\text{К}^{-1}$. Таким образом, с учетом того, что погрешность определения теплоемкости согласно данным по энталпии составляет 4—5 %, предложенный способ ее расчета можно считать вполне приемлемым для оценки высокотемпературной теплоемкости экспериментально неисследованных силицидов Ln_5Si_3 . С использованием уравнения (5) нами рассчитаны теплоемкости силицидов Nd_5Si_3 , Pm_5Si_3 , Sm_5Si_3 . Полученные данные в интервале температур 298.15— $T_{\text{пл}}$ представлены в виде уравнения:

$$C_p(T) = AT + B + CT^{-2}. \quad (6)$$

Коэффициенты (6) рассчитаны методом наименьших квадратов и приведены в табл. 3. Среднее отклонение рассчитанных по уравнению (5) величин теплоемкости от аппроксимированных по (6) составило (%): 0.8 (Nd_5Si_3), 0.4 (Pm_5Si_3), 0.6 (Sm_5Si_3). В табл. 3 не приведены коэффициенты температурной зависимости теплоемкости Ce_5Si_3 . У этого соединения темп роста теплоемкости значительно более высокий, чем у других изоструктурных силицидов [16], что, согласно [17, 18], может быть связано с переменной валентностью атома металла.

Таблица 3

Коэффициенты температурных зависимостей теплоемкости ($\text{Дж}\cdot\text{моль}^{-1}\cdot\text{К}^{-1}$) силицидов неодима, прометия и самария

Силицид	$A \cdot 10^3$	B	C
Nd_5Si_3	35.576	218.13	-2187028
Pm_5Si_3	50.102	209.69	-1447680
Sm_5Si_3	28.871	245.09	-3571880

ла и нелинейным по температуре вкладом в электронную теплоемкость.

Температуры плавления трех исследованных силицидов определялись как среднее двух температур соответствующих последней экспериментальной точке твердой фазы и первой точке твердо-жидкой или жидкой фазы. Погрешность их определения включает и погрешность их измерения оптическим пирометром (0.8%). Величины энталпий плавления находились как разность энталпий, рассчитанных по уравнениям (1) и (2), в точке плавления. Изменение температур и энталпий плавления в ряду силицидов Ln_5Si_3 ($\text{Ln} = \text{La—Gd}$) показано на рис. 2. Здесь также приведены величины температур плавления силицидов, определенные методом ДТА. Обращает на себя внимание хорошее совпадение температур плавления силицидов,

Т а б л и ц а 4

Температуры (К), энталпии ($\text{кДж}\cdot\text{моль}^{-1}$) и энтропии ($\text{Дж}\cdot\text{моль}^{-1}\cdot\text{К}^{-1}$) плавления низших силицидов РЗМ цериевой подгруппы

Силицид	$T_{\text{пл}}$	$\Delta H_{\text{пл}}$	$\Delta S_{\text{пл}}$
La_5Si_3	1589 ± 22 [5] 1533 [19]	102.3 ± 7.2	64.4 ± 4.5
Pr_5Si_3	1685 ± 23 [6] 1690 [20]	150.4 ± 10.4	89.3 ± 6.2
Nd_5Si_3	1720 [21]	161.4	93.8
Pm_5Si_3	1740* [4]	181.0	104.0
Sm_5Si_3	1725* [4]	200.7	116.4
Gd_5Si_3	1989 ± 18 [7] 1973 [22]	240.1 ± 12.9	120.7 ± 6.5

* Оценены.

ческой связи изоструктурных силицидов Ln_5Si_3 оказываются связи с участием атомов металла. Уменьшение объемов элементарных ячеек за счет эффекта лантаноидного сжатия ведет к увеличению доли ковалентной составляющей связей Me—Me и Me—Si в общей энергии связи соединения. Для оценки энталпий плавления силицидов цериевой подгруппы состава Ln_5Si_3 , энталпии которых для твердой и жидкой фаз не определены, использованы величины энталпий плавления силицидов La_5Si_3 , Pr_5Si_3 , Gd_5Si_3 . Энталпия плавления силицида рассчитана как сумма взятых в пропорциональном соотношении энталпий плавления близлежащих соседей по ряду РЗМ. Энтропии плавления определены на основе данных по энталпиям плавления и температурам плавления, определенных методом ДТА (табл. 4).

РЕЗЮМЕ. На основі експериментально визначених температурних залежностей енталпій сполук Ln_5Si_3 ($\text{Ln} = \text{La, Pr, Gd}$) проведено розрахунок температурних залежностей теплоємності та енталпії плавлення для інших силіцидів церієвої підгрупи.

SUMMARY. On a basis experimentally obtained temperature dependences of enthalpies of compounds Ln_5Si_3 ($\text{Ln} = \text{La, Pr, Gd}$) we calculated of temperature dependences of heat capacity and enthalpy of melting for other silicides of cerium subgroup.

1. Самсонов Г.В., Дворина Л.А., Рудь Б.М. Силициды. —М.: Металлургия, 1979.

2. Мьюарка Ш. Силициды для СБИС. -М.: Мир, 1986.
3. Гладышевский Е.И. Кристаллохимия силицидов и германидов. -М.: Металлургия, 1971.
4. Буянов Ю.И., Великанова Т.Я., Лузан С.П. и др. Особенности взаимодействия редкоземельных металлов с кремнием. -Киев, Ин-т пробл. материаловедения АН УССР, 1997.
5. Болгар А.С., Горбачук Н.П., Блиндер А.В. // Порошковая металлургия. -1994. -№ 3/4. -С. 48—53.
6. Горбачук Н.П., Болгар А.С., Блиндер А.В. // Там же. -1997. -№ 9/10. -С. 51—56.
7. Болгар А.С., Горбачук Н.П., Блиндер А.В. // Термофизика высоких температур. -1996. -34, № 4. -С. 541—545.
8. Литвиненко В.Ф., Болгар А.С., Муратов В.Б. и др. Обработка экспериментальных данных по энталпии с учетом дополнительных условий. -Киев: Ин-т пробл. материаловедения АН УССР, 1984.
9. Горбачук Н.П., Болгар А.С., Блиндер А.В. Термодинамические свойства силицидов. -Киев, 1995.
10. Ельяшевич М.А. Спектры редких земель. -М.: УНТЛ, 1953.
11. Крикля А.И. Дис. ... канд. хим. наук. -Киев, 1986.
12. Сафонов В.Н. Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук. -Свердловск, 1984.
13. Болгар А.С., Горбачук Н.П., Блиндер А.В., Моисеев Н.В. // Журн. физ. химии. -1994. -68, № 12. -С. 2124—2127.
14. Болгар А.С., Горбачук Н.П., Блиндер А.В., Моисеев Н.В. // Там же. -1996. -70, № 3. -С. 491—494.
15. Болгар А.С., Горбачук Н.П., Блиндер А.В. и др. // Термодинамика металлических сплавов. -1994. -Киев: Ин-т проблем материаловедения НАНУ. -С. 148—154.
16. Горбачук Н.П. // Порошковая металлургия. -2008. № 11/12. -С. 105—110.
17. Вайнштейн Э.Е., Бриль М.Н., Старый И.Б. и др. // Изв. АН СССР. Неорганические материалы. -1967. -3, № 4. -С. 644—648.
18. Атоян А.М., Барабанов А.Ф., Максимов Л.А. // Физика тв. тела. -1979. -21, № 1. -С. 15—22.
19. Bulanova M.V., Zheltov P.N., Meleshevich K.A. et al. // J. Alloys Compds. -2001. -329, № 1—2. -Р. 214—223.
20. Еременко В.Н., Мелешевич К.А., Буянов Ю.И. // Изв. вузов. Цвет. металлургия. -1986. -№ 3. -С. 82—87.
21. Еременко В.Н., Мелешевич К.А., Буянов Ю.И., Обушенко И.М. // Докл. АН УССР. Сер. А. -1984. № 11. -С. 80—85.
22. Еременко В.Н., Буянов Ю.И., Мелешевич К.А., Марченюк П.С. // Укр. хим. журн. -1991. -57, № 10. -С. 1047—1053.

Інститут проблем материаловедения им. И.Н. Францевича
НАН України, Київ

Поступила 13.05.2010

УДК 621.315.592:535

Д.М. Фреїк, Л.В. Туровська, Л.Й. Межиловська, І.В. Горічок

ТЕРМОДИНАМІКА І КРИСТАЛОХІМІЯ ТОЧКОВИХ ДЕФЕКТІВ У КРИСТАЛАХ PbTe ПРИ ДВОТЕМПЕРАТУРНОМУ ВІДПАЛІ *

Вперше, використовуючи метод термодинамічних потенціалів та кристалохімічний формалізм, визначено константи рівноваги квазіхімічних реакцій дефектоутворення та величину диспропорціонування зарядових станів катіонних вакансій та міжвузлового плюмбу в кристалах плюмбум телуриду при їх двотемпературному відпалі. Розраховано залежності концентрації домінуючих точкових дефектів та холлівської концентрації носіїв струму від технологічних факторів, встановлено умови реалізації термодинамічного *n-p*-перехіду.

У напівпровідниках $A^{IV}B^{VI}$, якщо вміст сторонніх домішок не перевищує фонової величини, тип і концентрація вільних носіїв заряду для області домішкової провідності зумовлені власними точковими дефектами кристалічної гратки [1, 2]. Плюмбум телурид характеризується двосторонньою областю гомогенності і має провідність *n*-ти-

пу при надлишку свинцю відносно стехіометричного складу і провідність *p*-типу при надлишку халькогену [1, 2]. У ряді робіт [3—5] прийнято, що в плюмбум телуриді переважаючими є дефекти Френкеля. Зроблено висновок, що донорні рівні, пов'язані із плюмбумом у міжвузлях (Pb_i), а акцепторні — з вакансіями плюмбу (V_{Pb}). Ці дані

* Роботу виконано в рамках наукових проектів МОН України (державні реєстраційні номери 0109U007537, 0107U006768).